

供給確保計画の概要

1. 認定の日付

令和5年12月8日

2. 供給確保計画の認定番号

2023半導体第18号—1

3. 供給確保事業者の名称等

ローム株式会社

ラピスセミコンダクタ株式会社

東芝デバイス&ストレージ株式会社

加賀東芝エレクトロニクス株式会社

4. 認定供給確保計画の概要

- 安定供給確保を図ろうとする特定重要物資又はその生産に必要な原材料等の品目
従来型半導体（SiC パワー半導体及び Si パワー半導体）、半導体部素材（SiC ウェハ）
- 特定重要物資等の安定供給確保に関する目標
SiC パワー半導体、Si パワー半導体及び SiC ウェハの国内における生産能力の強化
- 取組において支援措置の対象とする取組の内容
 - 取組の種類：1. 生産基盤の整備
 - ・施設の所在地：国富町（宮崎県）、能美市（石川県）
 - ・主要製品：SiC パワー半導体、Si パワー半導体及び SiC ウェハ

	生産場所	供給開始	生産能力
SiC パワー半導体	国富町	2026 年 4 月	72.0 万枚/年（6 インチ換算）
SiC ウェハ	国富町	2025 年 1 月	70.8 万枚/年（6 インチ換算）
Si パワー半導体	能美市	2025 年 3 月	42.0 万枚/年（12 インチ換算）

（※）供給開始の日から 10 年以上の継続生産を予定

- 取組を実施するために必要な資金の額：約 3,883 億円（最大助成額：約 1,294 億円）
- 希望する支援措置
助成金交付